

東京電機大学大学院 先端科学技術研究科 平成25年度 講義要目(シラバス)

科目名	電子物性・デバイス先端演習
英文名	Advanced Seminar on Physics of Electronic Materials and Electron Devices
学部学科	先端科学技術研究科 電気電子システム工学専攻
配当学年	1・2・3年次
開講時期	通年
単位数	4.0
必選区分	選択
担当者名	六倉 信喜

目的概要	電子物性・デバイス分野に関連する高度な知識を修得し、各自の独創的な研究活動を推進するための基礎力ならびに応用力を養うことを目的とする。
教科書名	特に指定しない。適宜必要に応じて紹介する。
参考書名	特に指定しない。適宜必要に応じて紹介する。
評価方法	演習における成果とその発表の内容により、評価する。
テーマ・内容	真空技術及びプラズマを用いた半導体単結晶薄膜形成、電子デバイスおよび半導体物性に関する国内外の論文を調査し、その内容の発表を通じて討議する。特に、III-V族窒化物半導体やII-VI酸化物半導体を主な対象とする。
E-Mail address	
履修上の注意事項・ 学習上の助言	